

## 求人募集要項：MBE エンジニア

■職務名称： MBE エンジニア

■配属部門： レーザデバイス事業部

■募集理由：当社は世界で初めて量子ドットを採用した 1300nm 帯半導体レーザを量産した会社で、MBE（分子線エピタキシー）装置による当社独自の結晶成長技術により世界最高峰の量子ドットを実現しております。量子ドット結晶成長は、これからの超情報化社会における通信の大容量化、高速化、低電力化を実現するシリコンフォトニクスの中核となる技術です。またその優れた結晶成長技術を量子井戸に展開し、加工用 1020-1180nm DFB レーザやバイオメディカル用 532-594nm 小型可視レーザを製造しております。今後ビジネスを拡大する上で、量子ドットおよび量子井戸レーザの高出力化、波長域拡大などの結晶成長技術開発業務を担うプロフェッショナルなエビエンジニアを募集いたします。

■開始時期： 2023 年 7 月頃から就業可能な方（早い方がよい）

■就業場所： 川崎市川崎区南渡田町 1-1 京浜ビル

■想定年収： 800 万円以上（処遇につきましては入社後の実績により適切に見直しを行います）

■雇用形態： 正社員

■業務内容：

・ MBE 装置によるデータ通信や LiDAR 用 1.3  $\mu$  m 帯量子ドットおよび加工・バイオメディカル用 1  $\mu$  m 帯量子井戸のエピ技術開発

具体的な業務は以下になります。

(1) 1.3  $\mu$  m 帯量子ドット：InAs 量子ドットの更なる特性改善のため高利得化や長波長化を行います。成長条件・成長方法の提案、エビ実施および特性確認により高性能量子ドットの開発を行っていただきます。

(2) 1  $\mu$  m 帯量子井戸：1020-1180nm InGaAs 量子井戸を用いた半導体レーザの更なる高出力化・高信頼性のための高歪系のエビ開発を行っていただき、当社加工・バイオメディカル用レーザの競争力強化に貢献いただきます。

・ ウェハ積層構造設計、評価、解析業務

・ MBE 装置の維持・管理

・ 顧客からの問合せに対する技術対応

■スキル／経験：

【必須要件】

・ MBE 結晶成長装置を用いたウェハの開発経験

・ MBE 結晶成長装置の稼働やメンテナンス経験

・ MBE 成長に関するメカニズム等の知識

・ エピタキシャル積層構造設計、評価、解析についての経験・知識

・ III-V 族化合物半導体（GaAs、InAs 等）についての知識、経験

・ III-V 族化合物半導体による半導体レーザの基礎知識

・ ビジネス英会話（目安：TOIEC 600 点以上）

**【人物像】**

- ・新しい技術に興味を持ち、自ら考え、自ら行動できる人
- ・強い意思を持って目標達成できる人
- ・開発、生産、営業メンバーとのチームワークを大切にしながら業務を遂行できる人

以上